

平成19年度東京大学大学院理学系研究科
物理学専攻 博士課程入学試験

物 理 学

平成19年2月6日（火） 9時30分～11時30分

問題は1～3まで3問ある。

問題ごとに別の答案用紙を使用し、全ての答案用紙に氏名、受験番号および問題番号を記入せよ。

問題 1

一次元調和振動を行っている質量 m の電子について、以下の設問に答えよ。

(1) 正準交換関係 $[\hat{p}, \hat{x}] = \hbar/i$ を満たす運動量 \hat{p} と位置座標 \hat{x} を用いてハミルトニアンは次の形で与えられる。

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

ただし、 ω は角振動数を表す。エルミート共役な昇降演算子

$$\hat{b}^\dagger = \alpha\hat{x} - i\beta\hat{p}, \quad \hat{b} = \alpha\hat{x} + i\beta\hat{p}$$

を導入し、

$$\hat{H}_0 = \gamma(\hat{b}^\dagger\hat{b} + \hat{b}\hat{b}^\dagger)$$

$$[\hat{b}, \hat{b}^\dagger] = 1$$

を満たすように、 α, β, γ を定めよ。

(2) ハミルトニアンの規格化された固有状態をエネルギーが低い方から順に $|n\rangle$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ と記す。 $\hat{b}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$, $\hat{b}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ を示し、状態 $|n\rangle$ のエネルギー固有値を求めよ。

(3) この系に一樣な電場を加えた場合を考えよう。ハミルトニアンは

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 - eE\hat{x} \\ &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 - m\omega^2\delta\hat{x} \end{aligned}$$

と与えられる。ここで e は素電荷、 E は電場の強さ、 $\delta = eE/m\omega^2$ であり、 δ は以後の式を見やすくするために導入した。 \hat{H} の固有状態を $|n\rangle_E$ と記そう。このハミルトニアンでの昇降演算子と、固有エネルギーを求めよ。答えは E ではなく、 δ を用いて記せ。

(4) $t < 0$ では電場がかかっていて、電子状態は電場中の基底状態 $|0\rangle_E$ であった。ここで、 $t = 0$ に瞬間的に電場を切る。電場を切った直後の波動関数は、直前の波動関数と等しいはずであるが、これは電場がないときのハミルトニアン \hat{H}_0 の固有状態ではなく、様々な状態 $|n\rangle$ の重ね合わせで、

$$|0\rangle_E = \sum_{n=0}^{\infty} a_n |n\rangle$$

と表される状態になっている。展開係数 a_n が満たす漸化式を導き出せ。

(5) a_n の値を求め、 $t > 0$ で電子が状態 $|n\rangle$ に見つかる確率を求めよ。ただし、状態間の遷移は起こらないものとする。

(6) 設問 (5) の結果を利用して、 $t > 0$ における \hat{x} の期待値が古典力学の場合と同じ時間変化をすることを示せ。

問題 2

質量 m , スピン 0 のボース粒子 N 個からなる体積 V の 3 次元理想気体を考える。 N は十分大きい数とし, V は一定とする。以下の設問に答えよ。

(1) エネルギー E と $E + \delta E$ の間にある状態の数を $D(E)\delta E$ とするとき, $D(E)$ を状態密度と呼ぶ。 $D(E)$ は \sqrt{E} に比例し, $D(E) = A\sqrt{E}$ と書ける。比例係数 A を求めよ。以下の問題では $D(E) = A\sqrt{E}$ としてよい。

(2) ボース統計では, 温度 T において, エネルギー E の 1 粒子状態を占有する粒子数の平均値は

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_B T} - 1}$$

で表される。 k_B はボルツマン定数, μ は化学ポテンシャルである。

(a) 基底状態 $E = 0$ の粒子数 N_0 の平均値が負にならないためには, $\mu < 0$ でなければならないことを示せ。

(b) $D(E) = A\sqrt{E}$ を用いて, 温度 T で励起状態 ($E > 0$) にある粒子の総数 N_e には最大値 N_e^{\max} が存在することを示せ。必要であれば, 以下の展開式および近似式を用いてよい。

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^{x+\alpha} - 1} dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{e^{-n\alpha}}{n^{\frac{3}{2}}}$$
$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \cong 2.612$$

(3) 設問 (2)(b) で求めた N_e^{\max} が全粒子数 N に一致する温度を T_c と呼ぶ。 $T < T_c$ のとき, N_e , および N_0 の全粒子数 N に対する割合, N_e/N , N_0/N を T と T_c を用いて表せ。

(4) 設問 (3) の結果から, $T < T_c$ では, 巨視的な数の粒子が基底状態にいることがわかる。基底状態の粒子数は $N_0 = f(0)$ と表される。このことから, 転移温度 T_c 以下では $|\mu|$ は $k_B T$ に比べて十分小さく,

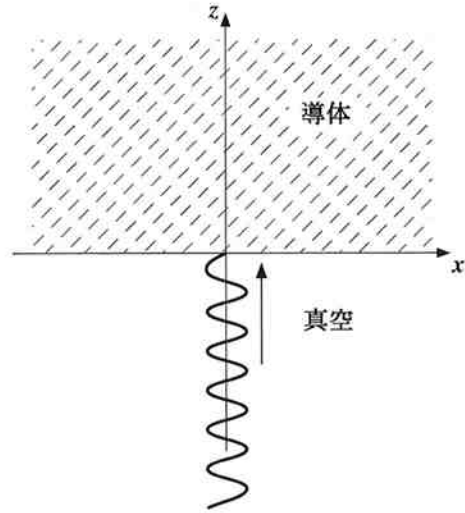
$$\mu \cong -\frac{k_B T}{N_0}$$

となることを示せ。

(5) $T \ll T_c$ では, 定積比熱は $T^{3/2}$ に比例することを示せ。ただし, $\mu = 0$ としてよい。

問題 3

右図のように下面が x - y 平面に一致する導体が $z \geq 0$ にある。この導体に向って角振動数 ω を持つ平面電磁波が z 軸方向に進んでいる。導体中には静電荷が存在しないとして、以下の設問に答えよ。



(1) 静電荷が存在しない時、マクスウェル方程式は以下のように書ける。

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= 0, & \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0, & \vec{\nabla} \times \vec{H} &= \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

ただし、 \vec{D} 、 \vec{B} はスカラー量である誘電率 ϵ と透磁率 μ を用いて $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 、 $\vec{B} = \mu \vec{H}$ と書けるものとする。上記の方程式を電場 \vec{E} 、磁場 \vec{H} の x 、 y 、 z 各成分を用いた方程式に書き下せ。

以下では、電場が x 成分のみを持つように直線偏向している電磁波を考える。この時、

$$E_x = E_0 e^{i(kz - \omega t)}, \quad E_y = 0 \quad (1)$$

$$H_y = H_0 e^{i(kz - \omega t + \alpha)}, \quad H_x = 0 \quad (2)$$

と書けるものとする。 α は電場と磁場の位相差で、真空中では 0 である。

(2) 真空中には電流が存在しないことを用いて、真空中で E_x が満たす微分方程式を導け。また、その方程式を解いて真空中における k と ω の関係を示せ。真空の誘電率と透磁率は各々 ϵ_0 、 μ_0 とする。

(3) 導体中では、 $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ の電流が生じる。ここで、 σ は電気伝導度である。導体中における k と ω の関係を求めよ。

(4) 設問 (3) の結果を用いて、電場の振幅が導体中で急速に減衰する (「表皮効果」と呼ばれる) ことを示せ。ここで、導体中の誘電率は小さく、 $\epsilon \ll \sigma/\omega$ が成り立つことを用いてよい。また、電磁波が導体中に入り込む深さ (電磁波の振幅が $1/e$ になる深さ) を求めよ。

(5) 電磁波の角振動数が $\omega = 2\pi \times 1.7 \text{ GHz}$ 、導体が銅 (電気伝導度 $\sigma = 5.9 \times 10^7 \text{ } \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$) の時、その具体的な数値を有効数字 1 桁で求めよ。導体中の透磁率は真空の透磁率と等しく、 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$ であるとする。

(6) 電場と磁場の振幅の関係は、

$$H_y = \frac{k}{\mu\omega} E_x \quad (3)$$

と与えられる。 $z = 0$ での電場と磁場の連続条件より、電磁波の反射率を求めよ。